

## 2SD795

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ  
低周波電力増幅用および低速度スイッチング用

NPN Silicon Epitaxial Transistor  
Audio Frequency Power Amplifier  
Low Speed Switching

## 特長

- DDモードドライブ用に最適である。
- $V_{CE(sat)}$  が小さい →  $V_{CE(sat)} \left( \frac{2A}{0.2A} \right) \leq 0.7V$
- $h_{FE}$  リニアリティが良く、 $h_{FE}$  も高い →  $h_{FE} \left( \frac{1V}{2.5A} \right) \geq 30$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

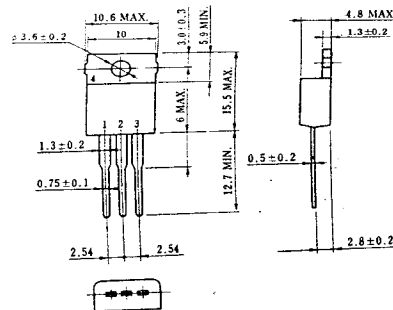
項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	40	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	3.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	6.0	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	0.6	A
全損失	$P_{T(T_c=25^\circ C)}$	20	W
全損失	$P_{T(T_a=25^\circ C)}$	1.5	W
ジャンクション温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ C$

\*  $PW \leq 10ms$ , duty cycle  $\leq 50\%$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 50V, I_E = 0$			1.0	$\mu A$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 3.0V, I_C = 0$			1.0	$\mu A$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 0.5A^*$	60	160	400	
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 2.5A^*$	30			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2A, I_B = 0.2A^*$		0.3	0.7	V
直流ベース電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 0.5A^*$		0.75	0.9	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 5.0V, I_C = 0.1A$		95		MHz
コレクタ容量	$C_{cb}$	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		40		pF

\*パルス測定  $PW \leq 350\mu s$ , duty cycle  $\leq 2\%$  / Pulse Test  
 $h_{FE}$ 区分( $h_{FE1}$ )/R: 60-120 Q: 100-200 P: 160-320 E: 200-400

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS  
(Unit: mm)

## 電極接続

1. Base EIAJ : SC-46
2. Collector (Fin) JEDEC : TO-220AB
3. Emitter IEC : -
4. Fin